

3DJ7 型硅 N 沟道耗尽型低频场效应晶体管												
	参数符号	单位	3DJ7						测试条件			
			D	E	F	G	H	I	J	符号	单位	D~J
极限参数	P_{CM}	mW	100						T_{amb}	°C	25	
	$V_{(BR)GSS}$	V	≥ 30						V_{DS}	V	0	
	$V_{(BR)DS}$	V	≥ 20						I_G	μA	-1	
									V_{GS}	V	$V_{GS(off)+(-)}$ 1)	
主要技术限制参数	I_{DSS}	mA	<0.35	0.3~1.2	1~3.5	3~11	11~21	20~30	30~40	V_{DS}	V	10
			$V_{GS(off)}$	V	$\leq -4 $			$\leq -9 $			V_{GS}	V
	I_{GSS}	nA	≤ 100						V_{DS}	V	10	
									I_D	μA	10	
	g_{fs}	WS	≥ 500	≥ 1000	≥ 2000	≥ 3000	≥ 4000	≥ 5000	≥ 6000	V_{DS}	V	10
			V_{GS}	V	-10							
			I_D	mA	3							
	C_{iss}	PF	≤ 6						V_{DS}	V	10	
									I_D	mA	3	
	C_{rss}		≤ 3						f	KHZ	1	
	F_n	dB	≤ 5						V_{DS}	V	10	
									I_D	mA	3	
									f	KHZ	30	
									R_g	KΩ	1	
	G_p	dB	≥ 12			≥ 15			V_{DS}	V	10	
			f	KHZ	3							
外形												
备注	对应型号 GS1 型 D、E、F 档在 $V_{GS}=0$ 条件下测试 电子技术 http://www.dzjsw.com/											